Московский Физико-Технический Институт

КАФЕДРА ОБЩЕЙ ФИЗИКИ Лабораторная работа №3.3.4

Эффект Холла в полупроводниках

Автор: Ришат ИСХАКОВ 513 группа

Преподаватель: Александр Александрович КАЗИМИРОВ



11 ноября 2016 г.

1 Цель работы

Измерение подвижности и концентрации носителей заряда в полупроводниках.

В работе используются: электромагнит с источником питания, амперметр, миллиамперметр, милливеберметр, реостат, цифровой вольтметр, источник питания, образцы легированного германия.

Теоретическая часть

Дырки

Эффект Холла, возникающий в проводниках, происходит из-за наличия некоторого количества свободных электронов в зоне проводимости и такого же количества дырок в валентной зоне. Чтобы понять причину образования дырок, нужно рассмотреть дырочную проводимость.

Дырочную проводимость можно объяснить при помощи следующей аналогии: если представить ряд людей, сидящих в аудитории, где нет запасных стульев. Когда кто-нибудь из середины ряда хочет уйти, он перелезает через спинку стула в пустой ряд и уходит. Здесь пустой ряд — аналог зоны проводимости, а ушедшего человека можно сравнить со свободным электроном. Теперь представим, что ещё кто-то пришёл и хочет сесть. Из пустого ряда плохо видно, поэтому там он не садится. Вместо этого человек, сидящий возле свободного стула, пересаживается на него, вслед за ним это повторяют и все его соседи. Таким образом, пустое место как бы двигается к краю ряда. Когда это место окажется рядом с новым зрителем, он сможет сесть. В этом процессе каждый сидящий передвинулся вдоль ряда. Если бы зрители обладали отрицательным зарядом, такое движение было бы электрической проводимостью. Если вдобавок стулья заряжены положительно, то ненулевым суммарным зарядом будет обладать только свободное место. Это простая модель, показывающая как работает дырочная проводимость. Однако на самом деле, изза свойств кристаллической решётки, дырка не локализована в определённом месте, как описано выше, а размазана по области размером во много сотен элементарных ячеек.

Эффект Холла

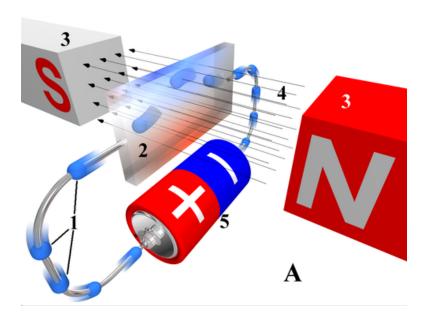


Рис. 1: Пример действия эффекта Холла на свободные заряды

Магнитного поле в проводнике действует на свободные электроны в зоне проводимости, поэтому между гранями наблюдается добавочная разность потенциалов, связанная с силой Лоренца.

$$F_{\Pi} = -eE - e\langle v \rangle \times B,$$

где e - абсолютная величина заряда электрона, B - индукция магнитного поля, E - напряженность электрического поля, $\langle v \rangle$ - средняя скорость заряда.

Из этого выражения получим разность потенциалов между двумя гранями:

$$U = -E_z l = -|\langle v \rangle| B l \tag{1}$$

С этой возникшей разностью потенциалов и связан Эффект Холла. Далее, если выразить ток:

$$I = ne|\langle \psi \rangle| la$$

И совместить его с 1, получим ЭДС Холла:

$$\mathscr{E}_x = U = -\frac{IB}{nea} = -R_x \cdot \frac{IB}{a},\tag{2}$$

где $R_x = \frac{1}{ne}$ называется постоянной Холла.

Установка и параметры измерения

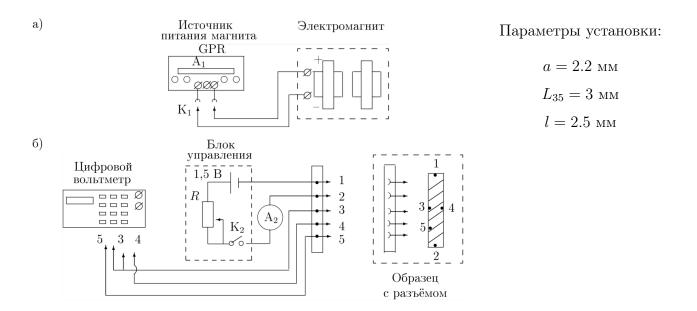


Рис. 2: Схема установки для измерения эффекта Холла в полупроводниках

В нашей установке

вдоль длинной стороны образца будет течь ток, величина которого регулируется реостатом R_2 . Так как он помещен в электромагнит, между точками $3\ u\ 4$ будет возникать разность потенциалов U_{34} , которую мы будем измерять.

Однако между точками 3 u 4 будет возникать некоторое дополнительное падение напряжения U_0 , так как эти точки оказываются не на одной эквипотенциали. Исключить это влияние можно с помощью изменения направления магнитного поля: в одном случае $U_{34} = U_0 - \mathscr{E}_x$, в другом $U_{34} = U_0 - \mathscr{E}_x$. Тогда с помощью полуразности избавимся от U_0 в наших измерениях.

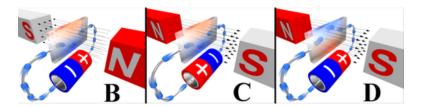


Рис. 3: Эффект Холла при различных направлениях магнитного поля и тока через образец

2 Работа и измерения

Калибровка установки

Γ	I, мА	0	0.1	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6
	B, Тл	22.4	115.8	431	616.5	791.2	912.4	1000.5	1061.5	1107.9

Таблица 1: Данные для калибровки установки

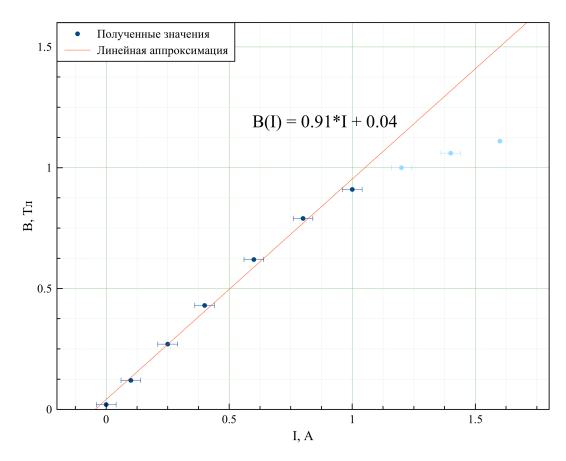


Рис. 4: Уравнение для калибровки установки

I, MA	U_0 , MB	I_M , A	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1
		В, Тл	0.131	0.222	0.313	0.404	0.495	0.586	0.768	0.95
0.3	-0.01	U , м B	-0.014	-0.02	-0.025	-0.031	-0.036	-0.041	-0.051	-0.059
		\mathscr{E}_x , мВ	-0.004	-0.01	-0.015	-0.021	-0.026	-0.031	-0.041	-0.049
0.4	-0.014	U , м B	-0.02	-0.028	-0.035	-0.042	-0.049	-0.056	-0.069	-0.079
		\mathscr{E}_x , м B	-0.006	-0.014	-0.021	-0.028	-0.035	-0.042	-0.055	-0.065
0.5	-0.018	U, м B	-0.026	-0.035	-0.044	-0.054	-0.062	-0.07	-0.087	-0.099
		\mathscr{E}_x , мВ	-0.008	-0.017	-0.026	-0.036	-0.044	-0.052	-0.069	-0.081
0.7	-0.026	U , ${ m MB}$	-0.038	-0.051	-0.063	-0.075	-0.088	-0.1	-0.123	-0.139
		\mathscr{E}_x , мВ	-0.012	-0.025	-0.037	-0.049	-0.062	-0.074	-0.097	-0.113
0.8	-0.031	U , м B	-0.045	-0.058	-0.073	-0.088	-0.102	-0.117	-0.141	-0.16
		\mathscr{E}_x , м B	-0.014	-0.027	-0.042	-0.057	-0.071	-0.086	-0.11	-0.129
1	-0.039	U , м B	-0.055	-0.073	-0.091	-0.11	-0.128	-0.145	-0.176	-0.201
		\mathscr{E}_x , м B	-0.016	-0.034	-0.052	-0.071	-0.089	-0.106	-0.137	-0.162

Таблица 2: Зависимость ЭДС Холла от магнитного поля

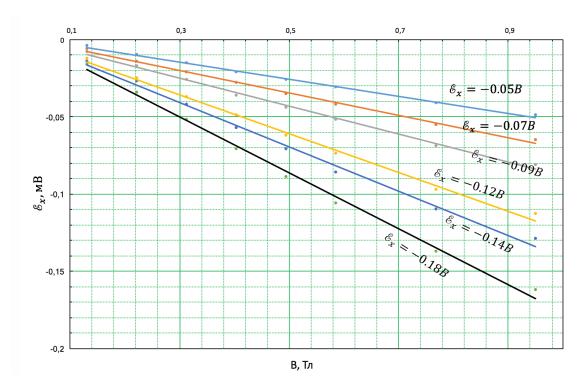


Рис. 5: Построим по полученным данным график зависимости $\mathscr{E}_x = f(B)$ для разных I

$$U_{35} = -1.72 \text{ MB}$$

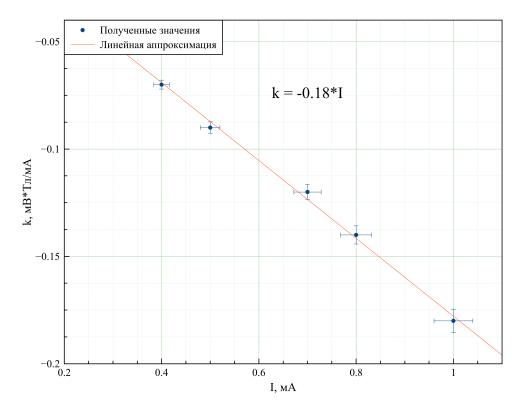


Рис. 6: Построим по полученным углам наклона график зависимости k=f(I)

Тогда
$$k_2=-(181\pm3)\frac{{}_{\mathrm{MK}}\mathrm{B}\cdot\mathrm{Tл}}{{}_{\mathrm{M}}\mathrm{A}}$$
 Определим постоянную Холла: $R_x=\frac{\mathscr{E}_x}{IB}\cdot a=-k_2\cdot a=(398\pm12)\cdot 10^{-6}$ Определим концентрацию носителей заряда: $n=\frac{1}{eR_x}=(1.5\pm0.1)\cdot 10^{22}\ 1/\mathrm{m}^3$ Вычислим удельную проводимость материала: $\sigma=\frac{IL_{35}}{U_{35}al}=(0.3\pm0.01)\cdot 10^3\ 1/\mathrm{Om}\cdot\mathrm{m}\ \left[\frac{\mathrm{Cm}}{\mathrm{m}}\right]$ Рассчитаем подвижность электрона: $b=\frac{\sigma}{en}=(1.24\pm0.05)\cdot 10^3\frac{\mathrm{cm}^2}{\mathrm{B}\cdot\mathrm{c}}$

3 Вывод

Мы определили постоянную Холла для Германия. Полученная проводимость n-типа. Измерили подвижность и концентрацию заряда в полупроводниках.